

대 한 민 국 특 허 KOREAN INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE

별첨 사본은 아래 출원의 원본과 동일함을 증명함.

This is to certify that the following application annexed hereto is a true copy from the records of the Korean Intellectual Property Office.

출 원 번 호 :

특허출원 2001년 제 10361 호

Application Number

출 원 년 월 일

2001년 02월 28일

Date of Application

줄

원

인

삼성전자 주식회사

Applicant(s)



2001 년

04 월

و 06

허 청 COMMISSIONEF



【서류명】 특허출원서

【권리구분】 특허

【수신처】 특허청장

 [참조번호]
 0009

【제출일자】 2001.02.28

【국제특허분류】 HO4N

【발명의 명칭】 마이크로렌즈를 구비한 고체 촬상 소자의 제조방법

【발명의 영문명칭】 Method for manufacturing solid imaging device with

microlens

【출원인】

【명칭】 삼성전자 주식회사

【출원인코드】 1-1998-104271-3

【대리인】

【성명】 이영필

[대리인코드] 9-1998-000334-6

 【포괄위임등록번호】
 1999-009556-9

【대리인】

【성명】 정상빈

 【대리인코드】
 9-1998-000541-1

【포괄위임등록번호】 1999-009617-5

【발명자】

【성명의 국문표기】 김상식

【성명의 영문표기】 KIM,Sang Sik

 【주민등록번호】
 640809-1899113

 【우편번호】
 442-470

【주소】 경기도 수원시 팔달구 영통동 신나무실 미주아파트 652동

1107호

【국적】 KR

[심사청구] 청구

【취지】 특허법 제42조의 규정에 의한 출원, 특허법 제60조의 규정

에 의한 출원심사 를 청구합니다. 대리인

이영필 (인) 대리인

정상빈 (인)

【수수료】			
【기본출원료】	15	면	29,000 원
【가산출원료】	0	면	0 원
【우선권주장료】	0	건	0 원
【심사청구료】	12	항	493,000 원

【합계】 522,000 원

【첨부서류】 1. 요약서·명세서(도면)_1통

【요약서】

[요약]

본 발명은 마이크로렌즈의 경도를 개선시킬 수 있는 고체 촬상 소자의 제조방법을 개시한다. 개시된 본 발명의 고체 촬상 소자의 제조방법은, 먼저 반도체 기판 상부에 다수의 광 감지 소자 어레이를 형성한 후, 광 감지 소자 어레이가 형성된 반도체 기판 상부에 다수의 마이크로렌즈를 형성한다. 다음으로, 마이크로렌즈에 DUV를 조사하여, 마이크로렌즈 표면을 경화시킨다.

【대표도】

도 3

【색인어】

DUV, 고체 촬상 소자, 마이크로렌즈

【명세서】

【발명의 명칭】

마이크로렌즈를 구비한 고체 촬상 소자의 제조방법{Method for manufacturing solid imaging device with microlens}

【도면의 간단한 설명】

도 1 내지 도 3은 본 발명에 따른 고체 촬상 소자의 제조방법을 설명하기 위한 각 공정별 단면도이다.

(도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명)

10 - 반도체 기판

12 - 전하 전송 전극

14 - 차광막

17 - 패드

20 - 컬러 필터

25 - 마이크로렌즈

【발명의 상세한 설명】

【발명의 목적】

【발명이 속하는 기술분야 및 그 분야의 종래기술】

- 본 발명은 마이크로렌즈를 갖는 고체 촬상 소자의 제조방법에 관한 것으로, 보다 구체적으로는, 마이크로렌즈의 경도를 향상시킬 수 있는 고체 촬상 소자의 제조방법에 관한 것이다.
- 의반적으로, 고체 촬상 소자는 민생용, 산업용, 방송용, 군수용 등 매우 다양한 응용 분야에 적용되고 있으며, 예컨대, 카메라, 캠코더, 멀티미디어, 감시카메라 등의 다양한 기기에 응용되고 있다. 현재에는 제품의 소형화 및 다 화소화 추세에 따라, 마이크

로렌즈를 구비하는 온 칩(on-chip) 방식의 고체 촬상 소자의 수요가 점차 증대되고 있다. 이와같은 고체 촬상 소자의 성능은 감도 및 수율에 따라 결정되고, 상술한 마이크로렌즈는 고체 촬상 소자의 감도를 향상시키는 역할을 한다.

- 이러한 마이크로렌즈는 볼록한 형상을 가지며, 통상 유기물, 예를들어 포토레지스 트 물질로 형성된다. 여기서, 마이크로렌즈의 볼록한 형상을 제공하기 위하여는 마이크 로렌즈 형성용 물질에 소정의 열에너지를 공급한다음, 마이크로렌즈 형성용 물질을 플로우시킨다. 이때, 곡률 제공 공정에 의하여, 마이크로렌즈 표면이 경화된다.
- 그러나, 종래의 마이크로렌즈는 포토레지스트와 같은 유기 물질로 형성되므로써, 고온에서 에너지를 공급하게 되면 쉽게 변성되어, 투과율이 변화된다. 이에따라, 현재에는 포토레지스트의 투과율이 변화되지 않는 범위 예를들어, 200℃ 이하에서 곡률 제공 공정을 진행하고 있다. 이때, 상기와 같은 저온에서 경화 공정이 진행되면, 마이크로렌즈, 즉 포토레지스트 표면의 연필 경도가 약 2 정도 수준에도 못미치게 되어, 후속의 조립 공정시 마이크로렌즈가 깨지거나 또는 다이를 자르는 공정시에 실리콘 가루가 마이크로렌즈에 박히게 된다. 이로 인하여, 마이크로렌즈에 흑점(黑点) 불량등이 발생되기 쉽다.
- <10>이와같이, 마이크로렌즈가 파손되거나 또는 흑점 불량이 발생되면, 고체 촬상 소자의 감도가 저하되며, 흑점 불량이 발생된다.

【발명이 이루고자 하는 기술적 과제】

<11> 따라서, 본 발명이 이루고자 하는 기술적 과제는, 고체 촬상 소자의 감도를 개선할수 있는 고체 촬상 소자의 제조방법을 제공하는 것이다.

<12> 또한, 본 발명이 이루고자 하는 다른 기술적 과제는 마이크로렌즈의 경도를 개선시킬 수 있는 고체 촬상 소자의 제조방법을 제공하는 것이다.

【발명의 구성 및 작용】

- ** 상기 기술적 과제를 달성하기 위하여 본 발명의 일 실시예에 따른 고체 촬상 소자는 다음과 같은 방법으로 제조된다. 먼저, 반도체 기판 상부에 다수의 광 감지 소자 어레이를 형성한다. 그 다음, 광 감지 소자 어레이가 형성된 반도체 기판 상부에 다수의 마이크로렌즈를 형성한 후, 마이크로렌즈에 광을 조사하여, 마이크로렌즈 표면을 경화시킨다. 이때, 마이크로렌즈에 광을 조사할 때, 광 조사후, 마이크로렌즈의 연필 경도가 7내지 10 정도가 되도록 하는 광을 조사하는 것이 바람직하다. 또한, 광은 DUV(deep UV)를 사용할 수 있다. 또한, 마이크로렌즈에 광을 조사할 때, 200 내지 400nm 대역 파장의 DUV광을 사용하여, 마이크로렌즈에 600 내지 1000mJ/cm의 광에너지가 공급되도록 조사한다.
- 여기서, 반도체 기판상에 다수의 광 감지 소자 어레이의 형성은, 먼저, 수개의 수 광부 및 수개의 전하 운송부가 한정된 반도체 기판 상부의 각각의 수광부 영역에 광다이오드를 형성한다. 이어서, 각각의 전하 운송부 영역에 전하 전송 전극을 형성한다음, 수 광부 영역이 노출되도록 차광막을 형성한다. 다음, 각각의 전하 전송 전극 및 차광막을, 인접하는 다른 전하 전송 전극 및 다른 차광막과 절연되도록, 절연막으로 고립시킨다. 그후에, 절연막 상부의 소정 부분에 패드를 형성하고, 패드가 형성된 반도체 기판 결과 물 상부에 평탄화막을 형성한다. 이때, 평탄화막 사이에 각각의 수광부 영역과 대응되도록 컬러 필터를 개재할 수 있으며, 평탄화막은 예를들어 투명 유기 물질로 형성할 수 있다.

- 또한, 다수의 마이크로렌즈의 형성은, 반도체 기판 결과물 상부에 마이크로렌즈용 물질을 형성한다음, 마이크로렌즈용 물질을 소정 부분 노광 및 현상하여, 렌즈 패턴을 형성한다. 그후에, 렌즈 패턴의 표면이 곡률 반경을 갖도록 열 에너지를 공급하여, 마이 크로렌즈를 형성한다. 여기서, 마이크로렌즈는 상기 각각의 수광부 영역과 대응되도록 형성한다. 또한, 마이크로렌즈용 물질은 예를들어 투명 유기 물질이 이용될 수 있다. 여 기서, 렌즈 패턴을 형성하는 단계와, 렌즈 패턴에 열 에너지를 공급하는 단계 사이에, 상기 렌즈 패턴의 투과율을 향상시키기 위하여, 렌즈 패턴에 UV를 조사할 수 있다. 이때 , UV는 500 내지 2000mJ/cm²의 에너지로 조사하는 것이 바람직하다.
- 한편, 본 발명의 다른 실시예에 따른 고체 촬상 소자의 제조방법은 다음과 같다.
 먼저, 반도체 기판 상부에 다수의 광 감지 소자 어레이를 형성한 후, 광 감지 소자 어레이가 형성된 반도체 기판 상부에 다수의 마이크로렌즈를 형성한다. 다음으로, 마이크로 렌즈에 DUV를 조사하여, 마이크로렌즈 표면을 경화시킨다.
- <17> 여기서, 마이크로렌즈에 DUV를 조사할 때, 상기 마이크로렌즈의 연필 경도가 7 내지 10 정도가 되도록 DUV를 조사하는 것이 바람직하다. 또한, 마이크로렌즈에 DUV를 조사할 때, DUV는 200 내지 400nm 대역 파장의 DUV를 사용하고, 마이크로렌즈에 600 내지 1000mJ/cm²의 광에너지가 공급되도록 조사하는 것이 바람직하다.
- <18> (실시예)
- 이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명에 따른 바람직한 실시예를 상세하게 설명하기로 한다. 그러나, 이하의 실시예는 이 기술분야의 통상적인 지식을 가진 자에게 본 발명이 충분히 이해되도록 제공되는 것으로서 본 발명의 범위를 한정하는 것으로 해석되어 져서는 아니된다. 이하의 설명에서 어떤 층이 다른 층의 위에 존재한다고 기술될 때, 이

는 다른 층의 바로 위에 존재할 수도 있고, 그 사이에 제3의 층이 게재될 수도 있다. 또한 도면에서 각 층의 두께나 크기는 설명의 편의 및 명확성을 위하여 과장되었다. 도면 상에서 동일 부호는 동일한 요소를 지칭한다.

- <20> 첨부한 도면 도 1 내지 도 3은 본 발명의 일실시예에 따른 고체 촬상 소자의 제조 방법을 설명한 각 공정별 단면도이다.
- <21> 먼저, 도 1을 참조하여, 반도체 기판(10)은 수광부(a)로 한정된 영역에 공지의 방 법으로 광다이오드(도시되지 않음)를 형성한다. 그후, 수광부(a) 양측의 전하 운송부(b) 에 전하 전송을 제어하는 전하 전송 전극(12)을 형성한다. 이때, 전하 전송 전극(12)과 반도체 기판(10) 사이에는 절연을 위하여 제 1 절연막(11)을 형성한다. 그후, 수광부(a) 를 제외한 어레이(array) 영역을 덮도록, 차광막(14)을 형성한다. 이때, 차광막(14)은 수광부(a)로 광이 입사되는 것을 차단하며, 예를들어, 전하 전송 전극(12) 상부에 형성 될 수 있다. 아울러, 차광막(14)과 전하 전송 전극(12) 사이에는 제 2 절연막(13)이 형 성되어, 차광막(14)과 전하 전송 전극(12) 사이를 절연시킨다. 그후, 차광막(14)을 보호 하도록 반도체 기판(10) 결과물 상부에 보호막(16)을 형성한다. 이어서, 보호막(16), 제 2 절연막(12) 및 제 1 절연막(11)을, 차광막(14) 및 전하 전송 전극(12)을 둘러싸도록 패터닝한다. 이에따라, 각각의 차광막(14) 및 전하 전송 전극(12)은 이웃하는 다른 차광 막(14) 및 전하 전송 전극(12)과 섬 형태로 고립된다. 이어서, 보호막(16)의 소정 부분 에 패드(17)를 형성한다. 여기서, 패드(17)는 고체 촬상 소자 내부의 신호를 외부로 전 달하거나, 외부의 신호를 고체 촬상 소자 내부로 전달하는 역할을 한다. 패드(17)는 수 광부(a) 및 전하 운송부(b)가 연속적으로 배열되는 어레이 영역의 외곽 부분에 형성되며, 예를들어, 한 쌍의 패드(17)가 소정 간격을 두고 배열될 수 있다. 또한, 패드

2001/4/

(17)는 도전 특성이 우수한 금속으로 형성됨이 바람직하다. 여기서, 패드(17) 사이의 간격은 이후 다이(die)별로 소잉(sawing)되어질 스크라이브 라인(sl)이 된다.

- 지속해서 도 1을 참조하여, 보호막(16)이 형성된 반도체 기관(10) 상부에 제 1 평 단화막(18)을 형성한다. 제 1 평단화막(18)의 형성으로, 반도체 기관(10) 결과물은 평탄 한 표면을 갖게된다. 그후, 제 1 평단화막(18)의 소정 부분에 공지의 방식에 의하여 컬 러 필터(20)를 형성한다. 여기서, 각 컬러 필터(20)는 수광부(a)와 각각 대응되도록 형 성한다. 컬러 필터(20)가 형성된 반도체 기관(10) 결과물 상부에 제 2 평탄화막(22)을 소정 두께로 형성한다. 여기서, 제 1 및 제 2 평탄화막(18,22)은 투명한 물질로 형성됨 이 바람직하고, 예를들어, 포토레지스트 물질로 형성될 수 있다. 그 다음, 패드(17)가 형성된 영역이 노출되도록, 제 2 평탄화막(22)과 제 1 평탄화막(18)을 패터닝하여, 개구 부(w)를 형성한다. 이에따라, 반도체 기관(10) 상부에 광 감지 소자 어레이가 완성된다. 그후, 반도체 기관(10) 결과물 상부에 마이크로렌즈 형성용 물질(24)을 형성한다. 여기 서, 마이크로렌즈 형성용 물질은 투명한 유기 물질을 이용하는 것이 바람직하고, 예를들 어, 포토레지스트 물질을 이용한다. 아울러, 본 실시예에서는 마이크로렌즈 형성용 물질 로서, 노보랙 레진(Novolak Resin)이 사용하였다.
- 그후, 도 2에 도시된 바와 같이, 마이크로렌즈가 수광부(a)에 존재하도록, 마이크로렌즈 형성용 물질을 소정 부분 노광한다. 그리고 나서, 노광된 마이크로렌즈용 물질 (24)을 현상액에 디핑(dipping)하여, 마이크로렌즈 영역에 포토레지스트 물질로 된 렌즈 패턴(도시되지 않음)을 형성한다. 그 후, 마이크로렌즈 물질의 투과율을 향상시키기 위하여, UV를 조사할 수 있다. 이때, UV는 마이크로렌즈 물질이 가지고 있는 PAC(photo active compound)을 분해하여, 광의 흡수를 방지할 수 있다. 이러한 방법을 표백 처리

또는 블리칭(bleaching) 공정이라고 하며, 통상 가시 파장 500 내지 2000mJ/c㎡ 에너지로 조사할 수 있다. 다음, 렌즈 패턴(도시되지 않음)을 약 200℃ 이하의 온도에서 열처리, 즉 열 에너지를 공급하여, 렌즈 패턴을 플로우(flow)시킨다. 이에따라, 소정의 곡률 반 경을 갖는 마이크로렌즈(25)가 형성된다. 아울러, 이러한 열 에너지 공급에 의하여 마이크로렌즈(25) 표면은 약 2 정도의 연필 경도를 갖게된다. 물론, 개개의 마이크로렌즈 (25)는 컬러 필터(20)과 대응되면서, 수광부(a)와도 대응된다.

- 연필 경도가 약 2정도인 마이크로렌즈(25)는 상술한 종래 기술에서와 같이, 이후 조립 공정시, 리프팅되거나 파손될 위험이 높다. 이에따라, 본 발명에서는 마이크로렌즈(25)에 광, 예를들어, 딥유브이(deep UV, 이하 DUV)를 쪼여준다. 여기서, DUV는 200 내지 400nm 대역의 파장을 가지며, 마이크로 렌즈(25)에 600 내지 1000mJ/cm의 광 에너지를 공급하도록 조사된다. 그러면, 마이크로렌즈(25a)는 DUV 조사에 의하여, 막질이 치밀해지게 되며, 유기물 내부의 C=0, C=N 또는 N=N 분자간의 고리가 끊어지는 형태가 되어, 연필 경도가 약 7 내지 10 정도로 증대된다. 이때, 마이크로렌즈(25a)에 고온이 가해지지 않는다. 이에따라, 마이크로렌즈(25a)의 투과율 특성이 변화되지 않으면서도 경도가 증대된다. 여기서, 도면 부호 25는 광 조사 이전의 마이크로렌즈를 나타내고, 25a는 광 조사후 경화된 마이크로 렌즈를 나타낸다.
- 이와같이, 마이크로렌즈(25)의 경도가 증대되면, 이후 조립 공정이 진행되더라도, 마이크로렌즈(25)가 파손되는 현상이 현저히 감소된다. 아울러, 다이 소잉(sawing)시, 실리콘 가루가 발생되더라도, 마이크로렌즈(25)의 경도가 높으므로, 실리콘 가루가 마이

크로렌즈(25)에 박히지 않는다.

- <26> 또한, 본 발명은 상술한 실시예에만 국한되는 것은 아니다.
- <27> 예를들어, 본 발명의 실시예에서는 마이크로렌즈를 경화시키기 위한 광으로서 DUV를 사용하였다. 하지만 여기에 국한되지 않고, 조사후, 마이크로렌즈의 연필 경도를 7 내지 10 정도 증대시킬 수 있는 광원이라면 모두 적용될 수 있다.

【발명의 효과】

- 이상에서 자세히 설명된 바와 같이, 본 발명에 의하면, 마이크로렌즈 형성후, 마이 크로렌즈 표면에 DUV를 조사하여, 마이크로렌즈의 표면 경도를 증대시킨다. 이에따라, 후속의 조립 공정시 마이크로렌즈가 파손되는 현상이 감소되며, 다이 분리시, 실리콘 가루에 의한 흑점 현상이 발생이 감소된다.
- <29> 기타, 본 발명의 요지를 벗어나지 않는 범위에서 본 발명은 다양하게 변경실시할수 있다.

【특허청구범위】

【청구항 1】

반도체 기판 상부에 다수의 광 감지 소자 어레이를 형성하는 단계;

상기 광 감지 소자 어레이가 형성된 반도체 기판 상부에 다수의 마이크로렌즈를 형성하는 단계; 및

상기 마이크로렌즈에 광을 조사하여, 마이크로렌즈 표면을 경화시키는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 마이크로렌즈를 구비한 고체 촬상 소자의 제조방법.

【청구항 2】

제 1 항에 있어서, 상기 마이크로렌즈에 광을 조사하는 단계는,

상기 마이크로렌즈의 연필 경도가 7 내지 10 정도가 되도록 하는 광을 조사하는 것을 특징으로 하는 마이크로렌즈를 구비한 고체 촬상 소자의 제조방법.

【청구항 3】

제 1 항 또는 제 2 항에 있어서, 상기 광은 DUV(deep UV)인 것을 특징으로 하는 마이크로렌즈를 구비한 고체 촬상 소자의 제조방법.

【청구항 4】

제 1 항에 있어서, 상기 마이크로렌즈에 광을 조사하는 단계는,

200 내지 400nm 대역 파장의 DUV 광을 사용하여, 상기 마이크로렌즈에 600 내지 1000mJ/c㎡의 광에너지가 공급되도록 조사하는 것을 특징으로 하는 마이크로렌즈를 구비한 고체 촬상 소자의 제조방법.

【청구항 5】

제 3 항에 있어서, 상기 반도체 기판상에 다수의 광 감지 소자 어레이를 형성하는 단계는,

수개의 수광부 및 수개의 전하 운송부가 한정된 반도체 기판을 제공하는 단계;

상기 각각의 수광부 영역에 광다이오드를 형성하는 단계;

상기 각각의 전하 운송부 영역에 전하 전송 전극을 형성하는 단계;

상기 수광부 영역이 노출되도록 차광막을 형성하는 단계;

상기 각각의 전하 전송 전극 및 차광막을, 인접하는 다른 전하 전송 전극 및 다른 차광막과 절연되도록, 절연막으로 고립시키는 단계;

상기 절연막 상부의 소정 부분에 패드를 형성하는 단계; 및

상기 패드가 형성된 반도체 기판 결과물 상부에 평탄화막을 형성하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 마이크로렌즈를 구비한 고체 촬상 소자의 제조방법.

【청구항 6】

제 5 항에 있어서, 상기 평탄화막 사이에 상기 각각의 수광부 영역과 대응되도록 컬러 필터를 개재하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 마이크로렌즈를 구비한 고체 촬상 소자의 제조방법.

【청구항 7】

제 7 항에 있어서, 상기 평탄화막은 투명 유기 물질로 형성하는 것을 특징으로 하는 마이크로렌즈를 구비한 고체 촬상 소자의 제조방법.

【청구항 8】

제 5 항에 있어서, 상기 다수의 마이크로렌즈를 형성하는 단계는,

상기 반도체 기판 결과물 상부에 마이크로렌즈용 물질을 형성하는 단계;

상기 마이크로렌즈용 물질을 소정 부분 노광 및 현상하여, 렌즈 패턴을 형성하는 단계; 및

상기 렌즈 패턴의 표면이 곡률 반경을 갖도록 열 에너지를 공급하여, 마이크로렌즈를 형성하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 마이크로렌즈를 구비한 고체 촬상 소자의 제조방법.

【청구항 9】

제 8 항에 있어서, 상기 마이크로렌즈는 상기 각각의 수광부 영역과 대응되도록 형성하는 것을 특징으로 하는 마이크로렌즈를 구비한 고체 촬상 소자의 제조방법.

【청구항 10】

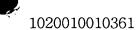
제 9 항에 있어서, 상기 마이크로렌즈용 물질은 투명 유기 물질인 것을 특징으로 하는 마이크로렌즈를 구비한 고체 촬상 소자의 제조방법.

【청구항 11】

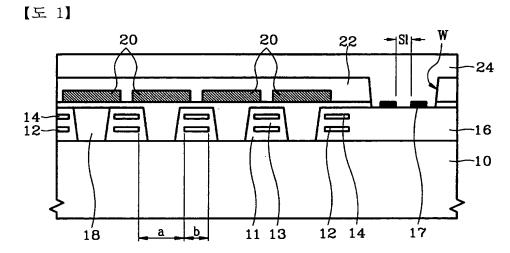
제 8 항에 있어서, 상기 렌즈 패턴을 형성하는 단계와, 렌즈 패턴에 열 에너지를 공급하는 단계 사이에, 상기 렌즈 패턴의 투과율을 향상시키기 위하여, UV를 조사하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 마이크로렌즈를 구비한 고체 촬상 소자의 제조방법.

【청구항 12】

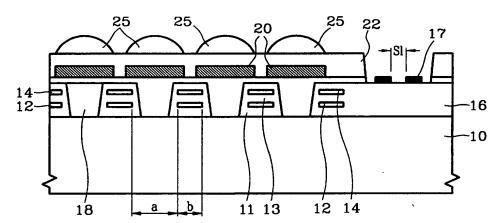
제 11 항에 있어서, 상기 UV는 500 내지 2000mJ/cm'의 에너지로 조사하는 것을 특징으로 하는 마이크로렌즈를 구비한 고체 촬상 소자의 제조방법.







[도 2]



[도 3]

